

Высокая стойкость к
электротермоциклированию
Низкие статические и динамические потери
Разработан для промышленного применения

Низкочастотный Диод Тип Д233-1000-18

Средний прямой ток			I_{FAV}	1000 А	
Повторяющееся импульсное обратное напряжение			U_{RRM}	1000 ÷ 1800 В	
U_{RRM} , В	1000	1200	1400	1600	1800
Класс по напряжению	10	12	14	16	18
T_i , °C			-60 ÷ 190		

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
Параметры в проводящем состоянии					
I_{FAV}	Средний прямой ток	А	1000 1155	$T_c=117$ °C; двухстороннее охлаждение; $T_c=100$ °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I_{FRMS}	Действующий прямой ток	А	1570	$T_c=117$ °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I_{FSM}	Ударный ток	кА	16.0 18.0	$T_j=T_{j \max}$ $T_j=25$ °C	180 эл. град. синус; 50 Гц ($t_p=10$ мс); единичный импульс; $U_R=0$ В;
			17.0 20.0	$T_j=T_{j \max}$ $T_j=25$ °C	180 эл. град. синус; 60 Гц ($t_p=8.3$ мс); единичный импульс; $U_R=0$ В;
I^2t	Защитный фактор	$A^2c \cdot 10^3$	1280 1620	$T_j=T_{j \max}$ $T_j=25$ °C	180 эл. град. синус; 50 Гц ($t_p=10$ мс); единичный импульс; $U_R=0$ В;
			1195 1660	$T_j=T_{j \max}$ $T_j=25$ °C	180 эл. град. синус; 60 Гц ($t_p=8.3$ мс); единичный импульс; $U_R=0$ В;
Блокирующие параметры					
U_{RRM}	Повторяющееся импульсное обратное напряжение	В	1000÷1800	$T_{j \min} < T_j < T_{j \max}$; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
U_{RSM}	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение	В	1100÷1900	$T_{j \min} < T_j < T_{j \max}$; 180 эл. град. синус; 50 Гц; единичный импульс	
U_R	Постоянное обратное напряжение	В	$0.75 \cdot U_{RRM}$	$T_j=T_{j \max}$;	
Тепловые параметры					
T_{stg}	Температура хранения	°C	-60÷190		
T_j	Температура р-п перехода	°C	-60÷190		
Механические параметры					
F	Монтажное усилие	кН	9.0÷11.0		
a	Ускорение	m/c^2	50 100	В не зажатом состоянии В зажатом состоянии	

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение и наименование характеристики		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
Характеристики в проводящем состоянии					
U _{FM}	Импульсное прямое напряжение, макс	В	1.55	T _j =25 °C; I _{FM} =3140 A	
U _{F(TO)}	Пороговое напряжение, макс	В	0.95	T _j =T _j max;	
r _T	Динамическое сопротивление, макс	МОм	0.350	0.5 π I _{FAV} < I _T < 1.5 π I _{FAV}	
Блокирующие характеристики					
I _{RRM}	Повторяющийся импульсный обратный ток, макс	mA	50	T _j =T _j max; U _R =U _{RRM}	
Тепловые характеристики					
R _{thjc}	Тепловое сопротивление р-п переход-корпус, макс	°C/Вт	0.040	Постоянный ток	Двухстороннее охлаждение
R _{thjc-A}			0.088		Охлаждение со стороны анода
R _{thjc-K}			0.072		Охлаждение со стороны катода
R _{thck}	Тепловое сопротивление корпус-охладитель, макс	°C/Вт	0.008	Постоянный ток	
Механические характеристики					
w	Масса, тип	г	180		
D _s	Длина пути тока утечки по поверхности	мм (дюйм)	23.69 (0.933)		
D _a	Длина пути тока утечки по воздуху	мм (дюйм)	19.10 (0.752)		

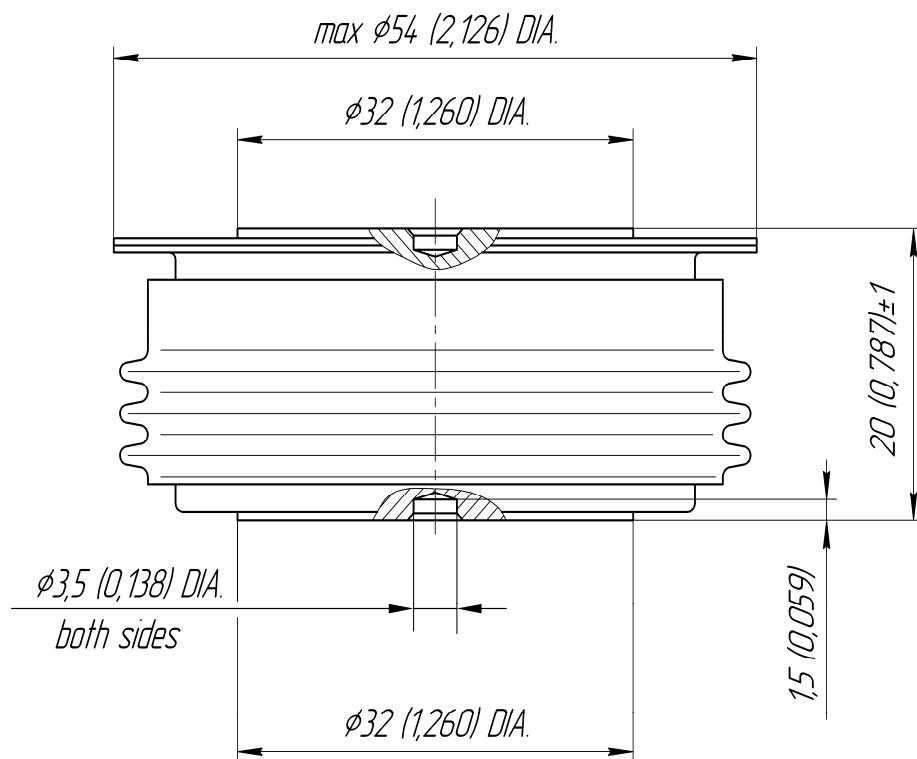
МАРКИРОВКА

Д	233	1000	18	УХЛ2
1	2	3	4	5

1. Д — Низкочастотный диод
2. Конструктивное исполнение
3. Средний прямой ток, А
4. Класс по напряжению
5. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип корпуса: D.B2



Все размеры в миллиметрах (дюймах)